
	<h2>SI8417DB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8417DB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8417DB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 219500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8417DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	219500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 14.5A (Tc) 2.9W (Ta), 6.57W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-MICRO FOOT™
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™ (1.5x1)
Verlustleistung (max)	2.9W (Ta), 6.57W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2220pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI8417DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8417DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8417DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8417DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8420-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8415DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.3A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8417DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP</p>	 <p>SI8416DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>
 <p>SI8420-B-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8416DB-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>	 <p>SI8420 SILICON SI8420 SILICON</p>	 <p>SI8416DB-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>

heiße Teile

Mehr

SI8401DB-T1-E3	SI8402DB-T1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1	SI8402DB-T1-E1.
SI8402DB-T1-E3	SI8404DB-T1-E1	SI8404DB-T1-E1	SI8405DB	SI8405DB-T1
SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E3	SI8405DB-T1-E3	SI8409DB-T1
SI8409DB-T1-E1	SI8409DB-T1-E1	SI8410AB	SI8410BB-D-ISR	SI8410BB-I-DS
SI8413DB-T1-E1	SI8413DB-T1-E1	SI8415DB-T1	SI8415DB-T1-E1	SI8415DB-T1-E1
SI8417DB-T2-E1	SI8420BB	SI8420BB-D-IS	SI8421AB-D-ISR	SI8422AB-D-ISR
SI8422BD	SI8424DB-T1-E1	SI8424DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1
SI8429DB-T1-E1	SI8429DB-T1-E1	SI8430-A-IS	SI8430-BIS	SI8430-C-IS
SI8430AB-D-IS	SI8430AB-D-ISR	SI8430BB-C-IS	SI8430BB-D-IS	SI8431-A-IS
SI8431-BIS	SI8431-C-IS	SI8431AB-C-IS	SI8431AB-D-IS	SI8431AB-D-IS1R

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited